



At RFMD®
Doug DeLieto
VP, Investor Relations
336-678-7088

請立即發布
2011年3月29日

RFMD 的 PowerSmart™ 獲頒化合物半導體業界之最創新元件獎

北卡羅萊納州 Greensboro, 2011年3月29日 -設計和製造高效能射頻元件及化合物半導體技術之全球領導者 RF Micro Devices, Inc. (Nasdaq: RFMD) 今日宣布 *Compound Semiconductor* 雜誌頒發該公司的 PowerSmart™ 功率平台 (RFRD6460) 為 2011 年化合物半導體業界之最創新元件。該獎項是於 2011 年 3 月 22 日由 *Compound Semiconductor* 雜誌於德國法蘭克福的 2011 CS Industry Awards 中頒發。

RFMD 的革命性 PowerSmart 功率平台具備射頻可配置功率核心 (RF Configurable Power Core™)，其提供所有行動通訊調變方案的多頻、多模涵蓋率，達 4G LTE 64QAM。PowerSmart 功率平台並於一個精小的參考設計內包括了所有必要的轉換和訊號處理功能，提供領導級元件製造商一個針對整個蜂巢式前端的單一可擴展來源。

RFMD PowerSmart 功率平台的卓越設計彈性，可協助智慧型手機和平板裝置的設計者免除數個月的開發時間，並透過單一設計涵蓋更廣泛的市場，同時相較於競爭性產品可節省相當程度的尺寸、功耗和研發成本。

RFMD 總裁暨執行長 Bob Bruggeworth 表示：「我們非常高興 *Compound Semiconductor* 雜誌肯定 RFMD 的 PowerSmart 為 2011 年化合物半導體業界最創新的元件。RFMD 專注於擴展我們於化合物半導體業界領導性至多重市場，我們相信 PowerSmart 位居多模、多頻智慧型手機轉移至聚合式前端的技術前鋒。」

「除了 GaAs PowerSmart 技術外，RFMD 於砷化鎵聚光型光電系統和氮化鎵高功率放大器的努力更於全球成長最快的市場中，協助延伸於化合物半導體業界的重要性。」

編輯 Richard Stevenson 表示：「*Compound Semiconductor* 以 CS Industry Awards 以及化合物半導體業界之熱烈響應為榮。我們認為表揚業界中的技術成就是很重要的，例如 RFMD 的 PowerSmart。這些類別和產品代表著在晶片製造過程中關鍵的創新領域。」

RFMD 近期已開始 RFRD6460 PowerSmart 功率平台的量產出貨，以支援 Samsung Galaxy S 2 系列的 3G/4G 智慧型手機和平板裝置，以及 LG Optimus 3D。該公司擁有強勢的智財地位，並透過多個申請中的專利支援 PowerSmart。

Compound Semiconductor 雜誌是全球化合物半導體社群中最具權威和最普遍的刊物。

關於 RFMD:

RF Micro Devices, Inc. (NASDAQ GS: RFMD) 是設計及製造高效能半導體元件之全球領導者。RFMD 的產品致能了全球的無線應用，為蜂巢式手機、無線基礎設施、無線區域網路 (WLAN)、CATV/寬頻及航太與國防應用提供強化的連結性與先進功能支援。RFMD 在半導體技術的多元化產品及 RF 系統專長廣受肯定，並且是全球領導行動裝置、用戶端及通訊設備供應商之優先廠商。

RFMD 總部設於北卡羅萊納州 Greensboro，該公司已獲得 ISO 9001- 及 ISO 14001- 認證，並擁有全球化的工程、設計、業務及服務據點。RFMD 於納斯達克全球精選市場以 RFMD 之代碼上市，如需進一步資訊，請參閱 RFMD 網站 www.rfmd.com

本新聞稿所包含“前瞻性聲明”，乃根據 1995 年「私人安全訴訟改革法案 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」中的「免責規定 (safe harbor)」所為。本文中的前瞻性聲明包括，但不限於關於本公司所擬計畫、目標、陳述及主張之聲明，其非歷史事實，典型以使用諸如：“也許”“將”“應該”“可能”“期望”“計畫”“預測”“相信”“預估”“預測”“潛力”“持續”及相似文字以界定。請注意此前瞻性聲明包含此間所效能管理者目前的判斷及期望，但我們的實際結果、事件及績效將可能與此前瞻性聲明之表達及暗示具有實質性的差異。我們並不會更新這些前瞻性聲明、或公開發表這些前瞻性聲明的修正結果，除非為聯邦證券法規 (federal securities laws) 之要求下。RF Micro Devices 的業務受多種風險及不確定性因素的影響，包括運營結果的易變性；與衝擊全球經濟及客戶信用條件以及供應商與客戶業務相關的風險，我們對於佔總體營收實質比例之少數大型客戶的依賴，無線市場的成長與發展速率，將新產品推向市場的能力，我們對於列入第三方參考設計為我們營收的一部分的依賴，我們管理通路夥伴及客戶關係的能力，以及下列風險：晶圓製造、分子束外延，裝配及測試、tape，捲線裝置，我們完成併購及統合所併購公司之能力，包括我們對來自業務整併的預期協同性的未知，我們吸引及保留熟練員工及培養領導者的能力，產能，原料成本及供貨的變化，降低成本、提高毛利率以降低平均銷售價格的能力，快速提高產能以因應產品需求成長的能力，將 GaAs 作為主要產品的依賴，以及對第三方的依賴，及對國際業務與營運的實質依賴。在由美國證券協議委員會歸檔的 RF Micro Devices 10-K 報表的最新年度報告中，更詳細討論的這些以及其他風險及不確定性因素，可能導致實際結果及發展與此處任何一個前瞻性聲明中明示或暗示的意義存在本質性偏差。

RF MICRO DEVICES®、RFMD®及 PowerSmart™為 RFMD, LLC. 註冊商標。其他品牌名稱、商標及註冊商標為其個別持有者所擁有。